

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

- Практические аспекты создания перспективных МДП структур с применением технологии атомно-слоевого осаждения
А. Ю. Алябьев, А. С. Коротков 243
- Оптимизация режимов ретроградного легирования кармана КНИ МОП-транзисторов СБИС
А. В. Амирханов, С. И. Волков, А. А. Глушко, Л. А. Зинченко, В. В. Макаrchук, В. А. Шахнов 252
- Исследование процесса образования окисной пленки нанометровой толщины на поверхности нитрида титана методом вторично-ионной масс-спектрометрии
В. М. Мордвицев, В. В. Наумов, С. Г. Симакин 258
- Релаксационная модификация морфологии атомно-чистой поверхности кристаллов кремния (100) после СВЧ плазменной обработки
Р. К. Яфаров 273
- Исследование характеристик и особенностей изготовления элементов энергонезависимой памяти FRAM, полученных с использованием процессов атомно-слоевого осаждения
О. М. Орлов, А. М. Маркеев, А. В. Зенкевич, А. Г. Черникова, М. В. Спиридонов, Р. А. Измайлов, Е. С. Горнев 280

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Особенности кинетики процесса CMP периодических структур при нелинейной зависимости скорости полирования от давления
Р. В. Гольдштейн, Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев 289

КИНЕТИКА ПЛАЗМЫ

- Кинетика нейтральных частиц в плазме HCl и HBr в условиях низких давлений и высоких концентраций электронов
А. М. Ефремов 298

МАТЕРИАЛЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

- Тонкопленочный отрицательный электрод на основе композита кремния для литий-ионных аккумуляторов
А. А. Айрапетов, С. В. Васильев, Т. Л. Кулова, М. Е. Лебедев, А. В. Метлицкая, А. А. Мироненко, Н. Ф. Никольская, В. В. Одинокоев, Г. Я. Павлов, Д. Э. Пухов, А. С. Рудый, А. М. Скундин, В. А. Сологуб, И. С. Федоров, А. Б. Чурилов 305

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

- Методика регистрации многократных сбоев в микросхемах памяти большой емкости при воздействии отдельных ядерных частиц
А. Б. Борудина, А. В. Уланова, А. И. Чумаков, А. В. Яценко 313